







	<h2 style="color: red;">S1JVNJD2873T4G</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: S1JVNJD2873T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANSISTOR PNP BIPO</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Lieferrn von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S1JVNJD2873T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANSISTOR PNP BIPO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 50mA, 1A
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Leistung - max	1.68W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	65MHz
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor NPN 50V 2A 65MHz 1.68W
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 500mA, 2V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	2A

S1JVNJD2873T4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S1JVNJD2873T4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S1JVNJD2873T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ S1JVNJD2873T4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S1JM RSG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A MICRO SMA</p>	 <p>S1JLS RVG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1.2A SOD123</p>	 <p>S1JLWHRVG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A SOD123W</p>	 <p>S1JLSHRVG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1.2A SOD123</p>
 <p>S1JMHRSG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A MICRO SMA</p>	 <p>S1JS R3 TSC S1JS R3 TSC</p>	 <p>S1JM RSG TSC TSC SOD-123</p>	 <p>S1JLW RVG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A SOD123W</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S1JVNJD2873T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	S1JVNJD2873T4G Datenblatt	S1JVNJD2873T4G-Datenblätter	S1JVNJD2873T4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor S1JVNJD2873T4G
S1JVNJD2873T4G Electronic	S1JVNJD2873T4G-Komponenten	S1JVNJD2873T4G-Verteiler	S1JVNJD2873T4G-Bild	S1JVNJD2873T4G-Teil
S1JVNJD2873T4G Preis	S1JVNJD2873T4G Hersteller	S1JVNJD2873T4G Bild	S1JVNJD2873T4G Aktie	S1JVNJD2873T4G Inventar
S1JVNJD2873T4G Neu	S1JVNJD2873T4G Original	S1JVNJD2873T4G garantiert	S1JVNJD2873T4G RFQ	S1JVNJD2873T4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited